







| | |
|---|---|
|  | <p>SI4666DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4666DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 16.5A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4666DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 21779 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | SI4666DY-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 25V 16.5A 8-SOIC |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 21779 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±12V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 10 mOhm @ 10A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 2.5W (Ta), 5W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1145pF @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 34nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 25V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 16.5A (Tc) |

SI4666DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4666DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4666DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4666DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>SI4666DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16.5A 8-SOIC</p> |  <p>SI4668DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p> |  <p>SI4660DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 23.1A 8-SOIC</p> |  <p>SI4668DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p> |
|  <p>SI4662DY-T1-GE3 V SI4662DY-T1-GE3 V</p> |  <p>SI4666DY-T1-E3 VISHAY SI4666DY-T1-E3 VISHAY</p> |  <p>SI4668DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p> |  <p>SI466A VISHAY VISHAY TSOP8</p> |

SI4666DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Schlüsselwort | SI4666DY-T1-GE3 Datenblatt | SI4666DY-T1-GE3-Datenblätter | SI4666DY-T1-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SI4666DY-T1-GE3 |
| SI4666DY-T1-GE3 Electronic | SI4666DY-T1-GE3-Komponenten | SI4666DY-T1-GE3-Verteiler | SI4666DY-T1-GE3-Bild | SI4666DY-T1-GE3-Teil |
| SI4666DY-T1-GE3 Preis | SI4666DY-T1-GE3 Hersteller | SI4666DY-T1-GE3 Bild | SI4666DY-T1-GE3 Aktie | SI4666DY-T1-GE3 Inventar |
| SI4666DY-T1-GE3 Neu | SI4666DY-T1-GE3 Original | SI4666DY-T1-GE3 garantiert | SI4666DY-T1-GE3 RFQ | SI4666DY-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited